Néologie en marche

numéro 36, 1984

Électronique
Biotechnologies

Myriam Urlich
Hélène Rivkine

Québec

Néologie en marche

104-04239/

numéro 36, 1984

Réalisation:

Service des publications
Direction des communications
Office de la langue française

© Gouvernement du Québec, 1984
Dépôt légal — 1er trimestre 1984
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISBN 2-551-06080-X
ISSN 0713-214X

Néologie en marche

numéro 36, 1984

Électronique
Biotechnologies

Myriam Urlich
Hélène Rivkine

Québec

Ce cahier a été préparé à Paris dans le cadre du réseau franco-québécois de néologie scientifique et technique (antenne parisienne : 10, boul. Raspail, 75007 PARIS)

sous la direction de

Alain Fantapié
Directeur de FRANTERM

avec le concours de

Jean-Claude Fantou
Inspecteur principal
des Télécommunications

Catherine Gueugnon
Ingénieur au centre de recherche
de CII — Honeywell Bull

Michel Sigot
Professeur à l'Université de
Technologie de Compiègne
(U.T.C.)

Marie-Françoise Sigot-Luizard
Chargée de recherche au CNRS

Francine Vermeersch
Responsable de la mise en oeuvre
et du fonctionnement de la banque
de données en génie enzymatique à
l'Université de Technologie de
Compiègne (U.T.C.)

l'équipe du laboratoire de
Technologie Enzymatique de l'U.T.C.
sous la direction du
Professeur Daniel Thomas

et la participation des ministères
de l'Éducation Nationale, de
l'Environnement, des P.T.T., des
Relations Extérieures

Avant-propos

Le module de néologie parisien livre dans cet ouvrage son sixième cahier portant sur de grands secteurs de technologie de pointe; il continue ainsi, en liaison étroite avec l'Office de la langue française du Québec, d'inventorier les domaines où la langue française demeure lacunaire, de façon à circonscrire un plan d'intervention prioritaire portant sur les sciences et techniques pour lesquels un travail de néologie aujourd'hui ponctuel, demain plus large, se révèle indispensable.

Paris, avril 1983 Le module parisien

Notice méthodologique

La structure de l'article

Pour chacun des néologismes traités, on a rassemblé à l'intérieur d'un article (1) un certain nombre de renseignements terminologiques, afin de permettre aux lecteurs de mieux cerner la réalité décrite. La nomenclature est présentée en ordre alphabétique.

L'article comprend, entre autres, une entrée, une ou des sous-entrées, les mentions de l'indicatif de grammaire et du domaine d'emploi, le ou les contextes et parfois des illustrations. Toute entrée est précédée d'un numéro de notion, avec en regard l'équivalent anglais, s'il y a lieu. Un index en fin de cahier facilite le repérage des entrées anglaises et chaque terme est suivi du numéro de l'article correspondant.

1. L'ENTRÉE française peut faire l'objet d'un article ou d'un renvoi. Dans ce dernier cas, le VOIR indique l'entrée principale qui a donné lieu à un article où l'on retrouve l'entrée-renvoi en sous-entrée (cf. exemples ci-après: NEM 1, 165, 171, 178 et le paragraphe 3).

L'unité néologique est en lettres capitales et elle a nécessairement franchi l'étape du corpus d'exclusion. (Voir Néologie en marche, série b, n° 1.) Elle peut être accompagnée ou non d'un contexte; sans contexte, elle est:

- soit une création du comité de référence en néologie, (elle est alors suivie de la mention: (terme prop.) [terme proposé] (2));

---

(1) Le titre des rubriques est toujours formulé au singulier même si celles-ci comportent plusieurs éléments.

(2) Dans ce cas il s'agit:
- soit d'un terme proposé comme équivalent d'un terme anglais trouvé en contexte anglais. Il fait l'objet d'une entrée principale suivie du contexte anglais. Exemple: NEM 1, 82. ÉOLIENNE TRIPALE À AXE VERTICAL, n.f. (terme prop.);

- soit d'un terme proposé comme équivalent d'un emprunt à l'anglais trouvé dans un contexte français. Il fait l'objet d'une entrée avec renvoi à l'entrée principale, qui reste l'emprunt.
Exemple: NEM 3, 115. VERROUILLAGE DE PHASE, n.m. (terme prop.)
voir PHASE-LOCK;

- soit d'un terme proposé comme substitut à un néologisme français jugé inacceptable ou mal formé.
Exemple: HÔTELLERIE NOUVELLE, n.f. (terme prop.)
voir NOTELLERIE.

- soit une unité nouvelle relevée, lors du traitement, dans un dictionnaire autre que ceux retenus dans le corpus d'exclusion. Une note vient le plus souvent en préciser l'origine. L'unité non néologique, donc consignée dans les dictionnaires généraux ou spécialisés du corpus, est en lettres minuscules.

Exemples d'articles

NEM 1, 170. STRATÉGIE MARKETING, n.f. marketing strategy
syn. STRATÉGIE DE MARCHÉ, n.f.
STRATÉGIE MERCATIQUE, n.f.

Domaine : mercatique/

Définition: Stratégie destinée à mettre en application la politique de l'entreprise quant à la conception d'un produit, à l'analyse du marché visé, au choix du réseau de distribution, et dont le but principal est de satisfaire les besoins du consommateur tout en assurant le maximum de rentabilité.

Contexte : Proposition d'une stratégie Marketing destinée à modifier le comportement du fumeur: cette stratégie repose sur une première différenciation de la population en trois groupes principaux en fonction du nombre de cigarettes fumées par les individus en une journée. Nous pouvons maintenant tenter de différencier et de décrire ces groupes, en fonction de certaines variables [...] (Commerce, vol. 77, n° 7, juillet 1975, p. 21).

Note : Le secteur de la gestion de l'OLF propose stratégie mercatique au lieu de stratégie marketing. Le terme mercatique peut s'utiliser tantôt comme substantif, tantôt comme adjectif.

Le Glossary of French and English Management Terms (Coveney (James) et Moore (Sheila J.), Londres, Longman, 1972, 146 p.) donne stratégie de marché comme équivalent de marketing strategy. Cette expression française est considérée comme un néologisme, car elle ne se trouve pas dans le corpus d'exclusion technique retenu.

Voir aussi: MARKETING SOCIAL; STRATÉGIE DISTRIBUTION.

NEM 1, 165. STRATÉGIE DE MARCHÉ
voir STRATÉGIE MARKETING

NEM 1, 171. STRATÉGIE MERCATIQUE
voir STRATÉGIE MARKETING

NEM 1, 178. surrégénération
voir SURGÉNÉRATION

2. L'INDICATIF de GRAMMAIRE est signalé sous forme abrégée après l'entrée et les sous-entrées françaises. Les unités complexes (ou syntagmes) sont considérées comme des unités simples et prennent la catégorie grammaticale et le genre de la base (ex. satellite technologique des télécommunications, n.m.). Certaines appellations d'emploi ne portent pas la mention du genre, car elles peuvent s'appliquer aussi bien au masculin qu'au féminin (ex. audiovidéothécaire, n.). La liste des abréviations utilisées dans ce numéro suit cette notice méthodologique.

3. Les SOUS-ENTRÉES, citées en retrait de l'entrée tant en anglais qu'en français, peuvent être de différents types: elles signalent une VARIANTE ORTHOGRAPHIQUE (var.), c'est-à-dire une modification de l'entrée au niveau d'une lettre ou d'un signe (ex. télépost/téléposte; agrotechnique/agro-technique); une ABRÉVIATION (abrév.) sous forme de sigle (ex. gestion par objectifs/GPO) ou résultant de la réduction d'une unité simple ou complexe (ex. télévision par câble/câble); un SYNONYME (syn.), la synonymie étant entendue ici au sens large, comme désignant des formes concurrentes renvoyant à un même référent, et dont les conditions de réalisation peuvent différer (ex. équilinguisme/bilinguisme équilibré); ou enfin un TERME PROPOSÉ (terme prop.) par le comité de référence: il s'agit d'une création visant à remplacer un emprunt relevé dans un contexte français (ex. phase-lock/verrouillage de phase), ou à remplacer un terme jugé inacceptable ou mal formé (ex. notellerie/hôtellerie nouvelle). Lorsqu'un synonyme en lettres minuscules est mentionné en sous-entrée d'un emprunt, il indique un terme déjà en usage, qu'il convient d'employer à la place de l'emprunt.

Exemples:

NEM 1, 17. ATTRACTION LINGUISTIQUE, n.f.
syn. ATTRACTION DES LANGUES, n.f.

NEM 1, 197. TÉLÉ-UNIVERSITÉ, n.f.
var. téléuniversité, n.f.
abrév. TU, n.f.

NEM 3, 84. PHASE-LOCK, n.m.
term. prop. VERROUILLAGE DE PHASE, n.m.

NEM 3, 8. CHOPPÉ, adj.
syn. découpé, adj.

L'ordre de présentation de l'entrée et des sous-entrées n'indique pas la forme à privilégier, mais il présente la genèse du traitement des néologismes (ex. extincteur volant/avion(-)citerne). Toutes les entrées, sauf les variantes exprimées par un signe typographique (ex. télé-université/téléuniversité) apparaissent dans la nomenclature et sont accompagnées d'un renvoi.

4. Les DOMAINES d'emploi ont une fonction surtout documentaire et permettent de circonscrire les secteurs d'activité où sont employés les termes. On distingue le domaine spécifique, auquel l'unité de signification appartient en propre, du domaine associé, reflétant le contexte d'utilisation de cette unité. Quelquefois, on n'attribue que l'un ou l'autre de ces domaines. Certains néologismes sont associés à plusieurs domaines: il s'agit dans ce cas de représenter chacun des contextes cités, ou de rattacher l'unité à un ensemble d'éléments de même nature, comme les appareils, les appellations d'emploi, etc. Quand il y a plus d'un domaine associé, ceux-ci sont séparés par un point-virgule. L'oblique suit le domaine spécifique et précède le domaine associé.

5. La DÉFINITION, élaborée le plus souvent avec l'aide du comité de référence en néologie, tente de respecter un certain niveau technique puisqu'elle s'adresse à un public spécialisé. Notre recherche portant sur la tranche la plus récente d'une terminologie donnée, le lecteur pourra avoir recours aux dictionnaires déjà publiés pour une meilleure compréhension du vocabulaire de base. Selon la nature de l'unité étudiée, des traits sémantiques énoncés en contextes et des suggestions des spécialistes consultés, on aura une définition largement explicative, descriptive ou synthétique. Lorsque la définition provient d'une source autre que celle du comité, on en mentionne la référence.

6. Le principal rôle du CONTEXTE est d'illustrer le fonctionnement de l'unité en discours, tout en donnant des renseignements d'ordre syntaxique et sémantique. Cet énoncé peut être constitué de quelques mots, d'une ou de plusieurs phrases. Bien souvent, en néologie, on recueille des attestations qui fournissent une simple occurrence d'un terme, par exemple dans un titre ou au sein d'une énumération. Selon le caractère plus ou moins analytique du texte dépouillé, on aura un contexte définitoire, descriptif ou encyclopédique. Si un néologisme a été employé plusieurs fois dans un même article, on ne retient que le contexte le plus significatif. Quand on le retrouve dans un autre texte, on ajoute cette citation au dossier. La fréquence n'est pas un critère de sélection en néologie scientifique et technique, mais dans certains cas une deuxième attestation vient souligner la pertinence du dépistage, par exemple le degré de lexicalisation.

Lorsque plusieurs contextes ont été retenus pour une même notion, ceux-ci sont numérotés et présentés selon l'ordre d'apparition des entrées et des sous-entrées (il en va de même pour les catégories grammaticales et les genres), le français précédant l'anglais. Les interventions des rédacteurs sont indiquées entre crochets de la façon suivante:

[...] : omission d'une partie du texte,
[texte] : ajout d'un membre de phrase,
[sic] : identification de toutes formes d'erreur dans le texte original.

La référence bibliographique détaillée est donnée entre parenthèses à la suite de chaque citation.

7. La NOTE peut comprendre des remarques linguistiques, terminologiques ou techniques, qui ont pour but de faciliter la compréhension du mot comme de la chose. Ainsi, on y trouve des explications quant aux procédés de formations néologiques, à l'origine géographique du néologisme, aux synonymes, etc. Les observations techniques tirées des articles dépouillés, de la documentation consultée, et surtout celles formulées par les spécialistes y figurent aussi. Notre souci est de rendre disponibles les créations néologiques, dans une perspective descriptive et non normative, tout en essayant d'exercer un esprit critique face aux formations qui ne correspondent pas au système morphologique du français.

8. Les renvois de type VOIR AUSSI n'ont pas comme objectif de reconstituer le champ sémantique ou lexical auquel appartient le néologisme, mais plutôt de reporter le lecteur à un article où il trouvera des renseignements supplémentaires nécessaires à la compréhension du terme qui l'intéresse. Par exemple stratégie marketing renvoie à marketing social, car en note de ce néologisme on signale l'origine du mot mercatique.

9. Lorsqu'il y a lieu, la SIGNATURE DU RÉDACTEUR de l'article est formée des initiales de l'auteur et du sigle du module auquel il est rattaché (JCB/OLF ou RL/MFN. L'explication de ces codes est donnée en tête du cahier. Toutes les rubriques qui ne sont pas suivies d'une source relèvent de la responsabilité du signataire de l'article qui en assure la rédaction finale après avoir consulté le comité de référence en néologie scientifique et technique.

Module québécois de néologie

Module français de néologie

Abréviations

abrév.	:	abréviation
adj.	:	adjectif
cf.	:	confer (comparez)
coll.	:	collaborateur(s); collection
etc.	:	et cetera
ex.	:	exemple(s)
f.	:	féminin
m.	:	masculin
n.	:	nom
NEM 1,	:	Néologie en marche, n° 1
		(même convention pour les numéros 2, 3, 4, etc.)
NEM 2, 150	:	Néologie en marche, n° 2, article n° 150
n°(s)	:	numéro(s)
p.	:	page(s)
s.p.	:	sans pagination
syn.	:	synonyme
terme prop.	:	terme proposé
v.	:	verbe
var.	:	variante
vol.	:	volume(s)

Dossiers terminologiques (1 à 48)

Électronique

Myriam Urlich

A C

1. APPROXIMATION DE DÉSERTION, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Hypothèse selon laquelle la concentration en porteurs est très inférieure à la concentration en impuretés.

Contexte : Pour calculer les caractéristiques de la région de charge d'espace qui se développe au voisinage de la jonction, nous supposons qu'elle provient entièrement de la charge des accepteurs et des donneurs ionisés. *[[...]]* Cette approximation est dite approximation de désertion (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 162).

2. APPROXIMATION DE LA JONCTION LINÉAIRE GRADUELLE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Hypothèse selon laquelle la concentration en impuretés varie linéairement de part et d'autre de la jonction.

Contexte : Alors que l'approximation de la jonction abrupte unilatérale fournit une description adéquate des jonctions alliées et des jonctions diffusées peu profondes, au contraire dans le cas de diffusions profondes, nous devons utiliser une autre approximation simple, appelée approximation de la jonction linéaire graduelle (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 169).

3. CONCENTRATION EN ACCEPTEURS, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Concentration en atomes d'impuretés qui ont un électron de moins que les atomes du semiconducteur.

Contexte : *[[...]]* On peut calculer la position du niveau de Fermi dans la bande interdite en fonction de la température pour une concentration en accepteurs ou une concentration en donneurs déterminée (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 108).

4. CONCENTRATION EN DONNEURS, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Concentration en atomes d'impuretés qui ont un électron de plus que le semiconducteur.

Contexte : *[[...]]* On peut calculer la position du niveau de Fermi dans la bande interdite en fonction de la température pour une concentration en accepteurs ou une concentration en donneurs déterminée (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 108).

5. CONCENTRATION EN DOPEURS, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Concentration des atomes d'impuretés avec lesquels on dope un semiconducteur intrinsèque.

Contexte : La condition pour laquelle la concentration exédentaire est négligeable devant la concentration en dopeurs est dite de faible niveau d'injection (Physique et technologie de dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 123).

6. CONCENTRATION INTRINSÈQUE D'UN SEMICONDUCTEUR, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Concentration en électrons ou en trous d'un semiconducteur pur.

Contexte : Nous pouvons nous attendre à ce que la concentration intrinsèque d'un semiconducteur soit fonction de l'énergie de vibration du réseau (donc de la température) qui est responsable de la rupture des liaisons (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 99).

7. COURANT DE DIFFUSION, n.m.

Domaine : électronique/technologie de diffusion

Définition : Courant dû à des porteurs majoritaires qui diffusent vers la zone désertée d'une jonction polarisée en inverse.

Contexte : Lorsque des paires électrons-trous sont générées dans les zones neutres 1 et 3 de la figure 6.18 et que ces porteurs diffusent vers la jonction polarisée en inverse, ils donnent lieu à un courant additionnel que nous appelons courant de diffusion (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 179).

8. COURANT DE GÉNÉRATION, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Courant dû à la génération de paires électrons-trous qui apparaissent dans la zone désertée d'une jonction polarisée en inverse.

Contexte : Donc, quand une paire électron-trou, entraînant un courant, est générée dans la zone désertée d'une jonction polarisée en inverse, zone 2 de la figure 6.18, nous le désignons sous le terme : courant de génération (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 179).

9. COURANT DE RECOMBINAISON, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Courant dû à la réunion de paires électrons-trous dans une jonction polarisée en direct.

Contexte : Les courants 1 et 3 sont dits courants de diffusion comme dans le cas de la polarisation en inverse, le courant 2 est appelé courant de recombinaison (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 188).

D E F

10. DIODE À L'ARSÉNIURE DE GALLIUM, n.f.

Domaine : électronique/composants et équipements

Définition : Diode semiconductrice fabriquée à partir d'arséniure de gallium.

Contexte : La diode à l'arséniure de gallium n'atteint pas la transition : mais, toutefois, une tendance en ce sens s'y manifeste (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 183).

11. DIODE AU GERMANIUM, n.f.

Domaine : électronique/composants et équipements

Définition : Diode semiconductrice fabriquée à partir de germanium.

Contexte : Les caractéristiques courant-tension de diodes au germanium, de diodes au silicium et de diodes à l'arséniure de gallium sont tracées pour différentes températures (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 183).

12. DIODE AU SILICIUM, n.f.

Domaine : électronique/composants et équipements

Définition : Diode semiconductrice fabriquée à partir de silicium.

Contexte : Les caractéristiques courant-tension de diodes au germanium, de diodes au silicium et de diodes à l'arséniure de gallium sont tracées pour différentes températures (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 183).

13. EFFET DE CONTRASTE DE POTENTIEL, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Méthode de visualisation au microscope électronique du fonctionnement d'un circuit intégré faisant intervenir l'effet électrostatique des charges électriques au sein du circuit.

Contexte : Il faut noter que cet effet de contraste de potentiel est non linéaire car la géométrie des champs électrostatiques locaux est elle-même non linéaire par suite des interactions avec les zones adjacentes de celle qui est en cours d'analyse (Mesures-Régulation-Automatisme, novembre 1981, p. 89).

14. ÉNERGIE DE FERMI, n.f.

syn. NIVEAU DE FERMI, n.m.

NIVEAU D'ÉNERGIE DE FERMI, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Niveau d'énergie des électrons d'un semiconducteur pour lequel la probabilité d'occupation de l'électron est égale à un demi.

Contexte : 1. *[[...]]* Cette fonction contient un paramètre, Ef, que l'on appelle le niveau de Fermi (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 102).

2. Cependant, en ce qui nous concerne, il suffit de considérer le niveau d'énergie de Fermi comme l'état d'énergie pour lequel la probabilité d'occupation par un électron est égale à un demi (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 102).

3. Si le nombre d'électrons dans la bande de conduction et le nombre de trous dans la bande de valence sont les mêmes, l'énergie de Fermi se trouve au milieu de la bande interdite.

15. FILM ÉPITAXIAL, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Film monocristallin obtenu par croissance cristalline à partir d'un substrat dont il prend l'orientation.

Contexte : *[[...]]* Une telle diode peut être fabriquée en faisant croître d'abord un film épitaxial de type p relativement peu dopé sur un substrat fortement dopé du même type, puis en oxydant du silicium (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 197' p. 155).

16. FILM STAGNANT, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Lors du mécanisme de croissance cristalline en phase vapeur, couche de gaz immobile située au-dessus du matériau semiconducteur et à travers laquelle diffusent les matières actives qui se déposent sur le matériau.

Contexte : Toutefois, l'épaisseur du film stagnant étant une quantité arbitraire, elle doit être déterminée expérimentalement pour un ensemble de conditions donné (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 14).

J

17. JONCTION ABRUPTE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction dans laquelle la concentration en impuretés des deux matériaux semiconducteurs est uniforme.

Contexte : Cette figure montre donc qu'une jonction p-n donnée ne peut être classée ni comme une jonction linéaire ni comme une jonction abrupte (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 173).

18. JONCTION ABRUPTE UNILATÉRALE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction abrupte dans laquelle la concentration en impuretés d'un côté de la jonction est beaucoup plus grande que celle de l'autre côté.

Contexte : Une jonction alliée et une jonction diffusée très peu "profonde" sont très proches de jonctions abruptes unilatérales (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 165).

19. JONCTION ALLIÉE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction obtenue par pénétration d'une couche de matériau contenant des impuretés dans le semiconducteur qu'on veut doper.

Contexte : Dans la jonction alliée, on place à la surface d'une plaque de semiconducteur de type n une pastille contenant des impuretés de type accepteur (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 2).

20. JONCTION DIFFUSÉE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction obtenue par diffusion des atomes dopants dans le semiconducteur à partir de la surface du matériau.

Contexte : Sur la figure 6.13, nous avons porté la largeur de la zone de charge d'espace en fonction de la polarisation inverse appliquée dans le cas d'une jonction diffusée (le silicium à la température ambiante) (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 173).

21. JONCTION LINÉAIRE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction dans laquelle la concentration de porteurs varie linéairement.

Contexte : Cette figure montre donc qu'une jonction p-n donnée ne peut pas être classée ni comme une jonction linéaire ni comme une jonction abrupte (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 173).

22. JONCTION LINÉAIRE GRADUELLE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction semiconductrice dans laquelle la concentration en impuretés varie linéairement de part et d'autre.

Contexte : La figure 6.12 montre la largeur de la zone désertée en fonction de la tension appliquée, pour des jonctions profondes, calculée à l'aide de l'approximation des jonctions linéaires graduelles (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 171).

23. JONCTION PLANAR, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction semiconductrice constituée de couches empilées de matériaux semiconducteurs.

Contexte : Lorsque cette variation de concentration ou lorsque la forme de la jonction planar conduisent à des résultats non conformes avec l'expérience, nous modifierons notre étude pour en tenir compte (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p.156).

24. JONCTION PN, n.f., terme prop.

var. JONCTION P-N, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Région de transition entre deux matériaux semiconducteurs de types différents.

Contexte : Cependant, l'importance des jonctions p-n est plus générale que ne le laisseraient supposer leurs applications en tant que diodes (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 157).

25. JONCTION P-N

voir JONCTION PN

26. JONCTION TIRÉE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Jonction obtenue par pénétration d'une couche de matériau contenant des impuretés dans le semiconducteur à partir d'un bain.

Contexte : La jonction tirée ne comportait, cependant, aucune possibilité de production de masse analogue à celle présentée dans les années suivantes par la jonction alliée (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 2).

M N

27. MÉTHODE STROBOSCOPIQUE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Méthode qui consiste à occulter périodiquement le faisceau d'un microscope électronique pour visualiser les effets de charges sur les circuits observés.

Contexte : C'est en ce sens que l'on parle pour cette technique de méthode stroboscopique (Mesures-Régulation-Automatisme, novembre 1981, p. 92).

28. NEUTRALITÉ DE LA CHARGE D'ESPACE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Caractérise un semiconducteur dans lequel les impuretés sont réparties uniformément de manière que la densité des charges soit nulle.

Contexte : Un semiconducteur dans lequel les impuretés sont distribuées uniformément, doit respecter la condition de la neutralité de la charge d'espace, ce qui se traduit par une densité de charge p nulle (Physique et technologie des dispositifs a semiconducteur, 1971, p. 105).

29. NIVEAU ACCEPTEUR, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Niveau d'énergie créé dans la bande interdite d'un semiconducteur par une impureté ayant un électron de moins que le semiconducteur.

Contexte : Il est bien connu que l'or a deux niveaux d'énergie, un niveau accepteur et un niveau donneur à environ 0,2 eV au-dessous du milieu de la bande interdite (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 146).

30. NIVEAU DE FERMI

voir ÉNERGIE DE FERMI

31. NIVEAU DE FERMI INTRINSÈQUE, n.m., terme prop.

syn. NIVEAU INTRINSÈQUE DE FERMI, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Niveau de Fermi d'un semiconducteur intrinsèque.

Contexte : Notons qu'en accord avec notre argument du chapitre 5, seuls les centres dont le niveau d'énergie E+ est proche du niveau intrinsèque de Fermi contribuent de façon efficace au taux de génération (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 180).

32. NIVEAU D'ÉNERGIE DE FERMI

voir ÉNERGIE DE FERMI

33. NIVEAU D'INJECTION, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Rapport de la concentration excédentaire en porteurs injectés à la concentration en dopeurs.

Contexte : Dans le cas d'un niveau d'injection élevé, la concentration excédentaire en porteurs injectés est plus grande ou au moins comparable à la concentration en ions donneurs (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 123).

34. NIVEAU DONNEUR, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Niveau d'énergie se situant juste au-dessous de la bande de conduction et créé dans la bande interdite d'un semiconducteur par une impureté ayant un électron de plus que le semiconducteur.

Contexte : Il est bien connu que l'or a deux niveaux d'énergie, un niveau accepteur et un niveau donneur à environ 0,2 eV au-dessous du milieu de la bande interdite (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 146).

35. NIVEAU INTRINSÈQUE DE FERMI

voir NIVEAU DE FERMI INTRINSÈQUE

O P R

36. OXYDATION THERMIQUE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Réalisation d'une couche d'oxyde sur un matériau, en chauffant ce dernier dans une atmosphère riche en oxygène.

Contexte : Dans la pratique industrielle, les couches de silice sont obtenues le plus souvent par oxydation thermique du silicium (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 23).

37. POLARISATION DIRECTE, n.f.

Domaine : électronique/électronique fondamentale

Définition : Mode de polarisation d'une jonction dans lequel la tension appliquée facilite le transit des électrons à travers la jonction.

Contexte : La polarisation correspondant au passage facile du courant est appelée polarisation directe (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 156).

38. PORTEUR MAJORITAIRE, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Porteur dont la concentration assure le passage du courant électrique à travers un semiconducteur.

Contexte : Le porteur dont la concentration est la plus importante est dit porteur majoritaire (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 108).

39. PORTEUR MINORITAIRE, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Porteur dont la concentration, due principalement à la chaleur, crée un courant parasite au sein du semiconducteur.

Contexte : Le porteur dont la concentration est la plus faible est dit porteur minoritaire.

40. QUASI-NIVEAU DE FERMI, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Niveau de Fermi des porteurs dans une jonction semi-conductrice soumise à un potentiel extérieur.

Contexte : Les quasi-niveaux de Fermi associés à la jonction p-n polarisée en inverse sont également indiqués dans la figure 6.8 (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 168).

41. RECOMBINAISON PAR TRANSITION DIRECTE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Processus de recombinaison des électrons de la bande de conduction d'un semiconducteur avec les trous de la bande de valence.

Contexte : Lorsque les électrons de la bande de conduction et les trous de la bande de valence se recombinent directement, on dit qu'il s'agit d'un processus de recombinaison par transition directe (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 132).

42. RECOMBINAISON THERMIQUE, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Annulation de paires électrons-trous donnant naissance à de la chaleur.

Contexte : Dans cette équation, en plus du terme de génération, et recombinaison thermique, nous avons inclus un terme Gl dû à une source extérieure de génération de porteurs, par exemple l'éclairement.

S T Z

43. SEMICONDUCTEUR INTRINSÈQUE, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Semiconducteur dans lequel les concentrations en électrons et en trous sont égales.

Contexte : On peut noter que lorsque la température augmente, le niveau de Fermi se rapproche du niveau de Fermi intrinsèque, et le semiconducteur devient alors un semiconducteur intrinsèque (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 108).

44. TAUX DE GÉNÉRATION, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Nombre de paires électrons-trous créées au sein de la zone désertée d'un matériau semiconducteur.

Contexte : Notons qu'en accord avec notre argument du chapitre 5, seuls les centres dont le niveau d'énergie E+ est proche du niveau intrinsèque de Fermi, contribuent de façon efficace au taux de génération (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 180).

45. TAUX DE RECOMBINAISON, n.m.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Définition : Taux de disparition d'une paire électron-trou.

Contexte : Pour calculer la concentration en porteurs minoritaires atteinte en régime permanent sous éclairement, nous pouvons remarquer que le taux d'augmentation de la concentration en porteurs minoritaires est égal au taux de génération total diminué du taux de recombinaison total (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 124).

46. ZONE D'APPAUVRISSEMENT

voir ZONE DE DÉPLÉTION

47. ZONE DE DÉPLÉTION, n.f., terme prop.

syn. ZONE DÉSERTÉE, n.f.

ZONE D'APPAUVRISSEMENT, n.f.

Domaine : électronique/technologie de fabrication

Défintion : Région d'un semiconducteur dans laquelle la densité de charges est très faible.

Contexte : Lorsque l'on intègre la distribution de charge linéaire, en utilisant l'équation de Poisson, on trouve un champ électrique parabolique et un potentiel suivant une loi cubique. En particulier, la largeur de la zone désertée, dite encore zone d'appauvrissement, est donnée par[[...]] (Physique et technologie des dispositifs à semiconducteur, 1971, p. 170).

48. ZONE DÉSERTÉE

voir ZONE DE DÉPLÉTION

Dossiers terminologiques (49 à 97)

Biotechnologies

Hélène Rivkine

A

49. ACCROCHAGE

voir ADHÉSION

50. ADHÉRENCE

voir ADHÉSION

51. ADHÉRER, v.

Domaine : biotechnologies/cultures de cellules

Définition : Maintenir sur un support.

Contexte : Si toutes les cellules adhèrent au support avec la même force, on s'attend à ce que *[[...]]* il apparaisse un front délimitant *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 142).

52. ADHÉSION, n.f.

syn. ACCROCHAGE, n.m.

ADHÉRENCE, n.f.

ATTACHEMENT, n.m.

Domaine : biotechnologies/cultures de cellules

Définition : Maintien de cellules sur un support par la mise en jeu d'interactions de type faible.

Contexte : 1. L'adhésion de cellules sur un support sans liant est réalisable soit spontanément, soit après un traitement pour amener les deux surfaces en contact intime (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 147).

2. Nous avons tenté de mesurer la force d'accrochage des cellules sur le verre en soumettant les échantillons à une centrifugation (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 142).

3. La déshydratation des cellules produit donc une meilleure adhérence qu'un séchage modéré (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 147).

4. L'examen microscopique se fait au faible grossissement et permet de suivre l'attachement des cellules, leur étalement puis l'envahissement progressif des microsupports (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 64).

53. ADSORPTION

voir IMMOBILISATION PAR ADSORPTION

54. ANCHORAGE DÉPENDANCE

voir ANCRAGE DÉPENDANT

55. ANCRAGE DÉPENDANT, n.m., terme prop.

syn. ANCHORAGE DÉPENDANCE, n.m.

Domaine : biotechnologies/cultures de cellules; microbiologie; immunologie

Définition : Présence indispensable d'un support permettant la multiplication de cellules animales normales.

Contexte : Le phénomène d'anchorage dépendance est pour la culture des cellules animales une donné essentielle (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 65).

56. ASSISE CELLULAIRE, n.f.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules; microbiologie; immunologie

Définition : Couche monocellulaire recouvrant une surface.

Contexte : *[[...]]* l'épaisseur critique correspond à une vingtaine d'assises cellulaires actives *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 133).

57. ATTACHEMENT

voir ADHÉSION

B C D E

58. BIOCOMPATIBILITÉ, n.f.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules; microbiologie; immunologie

Définition : Affinité d'un matériau non vivant pour des cellules vivantes.

Contexte : Le résultat montre que les tests de biocompatibilité ne peuvent être effectués avec n'importe quel type cellulaire *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 119).

59. CORÉTICULATION

voir IMMOBILISATION PAR CORÉTICULATION

60. DÉNOMBREMENT, n.m.

Domaine : biotechnologies/biologie; microbiologie

Définition : Action de compter des cellules ou des microorganismes.

Contexte : La viabilité des cellules est déterminée après leur dénombrement à la cellule de Thoma *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 155).

61. DÉTACHEMENT, n.m.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules; microbiologie; immunologie

Définition : Phénomène inverse de l'adhésion.

Contexte : De divers essais il résulte que la centrifugation dans l'eau ne permet pas le détachement des cellules *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 142).

Voir aussi : ADHÉSION, 53.

62. DÉTACHER (SE), v.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules

Définition : Quitter un support.

Contexte : On voit les cellules devenir ballonnisées *[[...]]* puis se détacher et éclater (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 64).

63. EN SUSPENSION

voir LIBRE

64. ÉTALEMENT, n.m.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules; microbiologie; immunologie

Définition : Action de s'étaler.

Contexte : *[[...]]* La possibilité de cultiver les cellules sur les deux types de supports, positif ou négatif, suppose la mise en jeu de mécanismes différents pour leur étalement (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 55).

65. ÉTALER (S'), v.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules; microbiologie; immunologie

Définition : Se multiplier sur un support en occupant toute la surface offerte.

Contexte : Les cellules ont pour règle commune de ne se multiplier que si elles disposent d'une surface solide pour se fixer puis s'étaler (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 48).

F G

66. FILM CELLULAIRE, n.m.

syn. FILM DE BIOMASSE, n.m.

FILM DE CELLULES, n.m.

Domaine : biotechnologies/culture de cellules; microbiologie

Définition : Résultat de l'immobilisation de microorganismes ou de cellules.

Contexte : 1. Il apparaît donc que si le film cellulaire résiste à l'immersion en milieu fortement agité, il peut cependant être déplacé par le ménisque existant à l'interface eau, verre, air (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 142).

2. [[...]] il s'agit de déterminer l'épaisseur optimale du film de biomasse à immobiliser sur les copeaux de bois (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 207).

3. Le modèle simple qui s'applique assez bien à l'activité respiratoire d'un film de cellules [[...]] conduit aux conclusions suivantes [[...]] (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 133).

Note : Faute de rigueur scientifique, le terme film de biomasse est à éviter.

67. FILM DE BIOMASSE

voir FILM CELLULAIRE

68. FILM DE CELLULES

voir FILM CELLULAIRE

69. FIXATION COVALENTE

voir IMMOBILISATION PAR FIXATION COVALENTE

70. GREFFAGE

voir IMMOBILISATION PAR FIXATION COVALENTE

71. GREFFER, v.

Domaine, : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Immobiliser par fixation covalente.

Contexte : b) membranes synthétiques obtenues en greffant par irradiation un monomère réputé hémocompatible sur un polymère de bonne résistance mécanique (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 118).

I

72. IMMOBILISATION PAR ADSORPTION, n.f., terme prop.

abrév. ADSORPTION, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie biochimique; génie enzymatique

Définition : Méthode d'immobilisation physique où n'interviennent que des interactions dites faibles, interactions hydrophobes, ioniques ou liaisons hydrogène.

Contexte : L'adsorption de levures sur des copeaux de bois représente une méthode très simple de production d'acide citrique *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 209).

73. IMMOBILISATION PAR CORÉTICULATION, n.f., terme prop.

abrév. CORÉTICULATION, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Immobilisation chimique d'une enzyme en présence d'un agent bifonctionnel et d'un support de nature protéique qui se forme simultanément.

Contexte : La coréticulation des molécules d'enzymes avec une protéine inerte apparaît comme une solution adéquate (S.F.M., Fermentation, réacteurs, capteurs et automatisation, 1980, p. 206).

Note : Ce type d'immobilisation aboutit à la formation entre l'enzyme et son support protéique d'une structure tridimensionnelle qui a l'aspect d'une membrane ou d'une mousse.

74. IMMOBILISATION PAR FIXATION COVALENTE, n.f., terme prop.

abrév. FIXATION COVALENTE, n.f.

syn. GREFFAGE, n.m.

Domaine : biotechnologies/génie biochimique; génie enzymatique

Définition : Immobilisation chimique d'un matériel tel qu'une enzyme, par exemple, sur un support avec ou sans réactif intermédiaire, agent bifonctionnel ou activateur.

Contexte : *[[...]]* Il s'agit ici d'une fixation covalente*[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 99).

75. IMMOBILISATION PAR INCLUSION, n.f., terme prop.

abrév. INCLUSION, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Immobilisation physique d'une enzyme à l'intérieur des cavités d'un gel obtenu par polymérisation.

Contexte : 1. Elle *[[* l'immobilisation par inclusion *]]* reste la méthode la plus fréquemment utilisée. (J.N. Barbotin, Réalisation de supports artificiels porteurs d'enzymes greffées, 1979, p. 11).

2. Cependant, l'inclusion entraîne de sérieuses limitations diffusionnelles (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 147).

Note : Cette méthode se caractérise par l'absence de toute intéraction entre le matériel biologique immobilisé et le support d'immobilisation structuré en treillis tridimensionnel permettant la libre diffusion des produits et des substrats.

76. IMMOBILISATION PAR INTERACTIONS IONIQUES, n.f., terme prop.

Domaine : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Type d'immobilisation par adsorption ou les intéractions ioniques jouent un rôle prépondérant au moment de l'immobilisation.

77. IMMOBILISATION PAR MICROENCAPSULATION, n.f., terme prop.

abrév. MICROENCAPSULATION, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Immobilisation physique par inclusion d'enzymes à l'intérieur de microcapsules.

Contexte : Schéma illustrant les différents modes d'immobilisation des enzymes *[[...]]* 2. Microencapsulation (J.N. Barbotin, Réalisation de supports artificiels, porteurs d'enzymes greffées : étude morphologique et cinétique, 1979, p. 11).

Note : Les microcapsules dont les membres sont généralement en nylon ou en collodion peuvent être préparées par polymérisation interfaciale ou par séparation de phase.

78. IMMOBILISATION PAR RÉTICULATION, n.f., terme prop.

abrév. RÉTICULATION, n.f.

syn. POLYMÉRISATION, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Immobilisation chimique d'une enzyme en l'absence de support par la mise en jeu de liaisons intermoléculaires de type covalent entre l'enzyme et un agent bi ou multifonctionnel.

Contexte : Pour chaque type d'activité enzymatique, il est nécessaire de contrôler la valeur du pH avant la réticulation *[[...]]* D'une manière générale, l'addition de sels (augmentation de la force ionique) empêche le bon déroulement de la réaction de polymérisation (J. N. Barbotin, Réalisation de supports artificiels porteurs d'enzymes greffées : étude morphologique et cinétique, 1979, p. 30).

79. IMMOBILISER PAR ADSORPTION, v., terme prop.

syn. RETENIR PAR ADSORPTION, v.

Domaine : biotechnologies/génie biochimique; génie enzymatique

Définition : Effectuer une immobilisation par absorption.

Contexte : a) Les microorganismes sont retenus par absorption (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 109).

80. IMMOBILISER PAR COVALENCE, v., terme prop.

syn. RETENIR PAR COVALENCE, v.

Domaine : biotechnologies/génie biochimique; génie enzymatique

Définition : Effectuer une immobilisation par fixation covalente.

Contexte : *[[...]]* b) Les microorganismes sont retenus par covalence (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 110).

81. INACTIVATION, n.f.

Domaine : biotechnologies/enzymologie

Définition : Perte d'activité enzymatique d'un catalyseur biologique.

Contexte : Et il propose que la diminution d'activité est du *[[sic]]* soit à une inhibition par des métabolites *[[...]]* soit par inactivation réversible d'une enzyme *[[...]]* (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 112).

Voir aussi : ACTIVITÉ ENZYMATIQUE, 35, 102.

82. INCLURE, v.

Domaine : biotechnologies/microbiologie industrielle

Définition : Retenir un microorganisme par le procédé d'immobilisation par inclusion.

Contexte : Il peut être intéressant sur le plan pratique d'inclure dans un premier temps une population peu concentrée *[[...]]* (S.F.M., Utilisation du carbone d'origine végétale, 1978, p. 199).

83. INCLUSION

voir IMMOBILISATION PAR INCLUSION

L M P

84. LIBRE, adj.

syn. EN SUSPENSION, adj.

Domaine : biotechnologies/microbiologie industrielle

Définition : Qui n'a pas été ou pu être immobilisé.

Contexte : 1. Tableau IV : évolution des constituants macromoléculairesdes cellules libres et des cellules incluses (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 163).

2. La nature de la consommation spécifique de cellules en suspension [[...]] donne 1,5-2 µg glucose/h par million de cellules (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 139).

85. MÉTHODE ENZYMATIQUE, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie enzymatique

Définition : Méthode de dosage d'un métabolite faisant intervenir une enzyme différente de celle utilisée dans la réaction de synthèse.

Contexte : Le glucose, le fructose et le saccharose ont été dosés par la méthode enzymatique (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 154).

86. MICROENCAPSULATION

voir IMMOBILISATION PAR MICROENCAPSULATION

87. MICROPORTEUR

voir MICROSUPPORT

88. MICROSUPPORT, n.m.

syn. MICROPORTEUR, n.m.

Domaine : biotechnologies/microbiologie industrielle; culture de cellules

Définition : Particule microscopique servant de support à une culture homogène de cellules.

Contexte : 1. *[[...]]* Sur microsupports la synthèse d'interféron requiert des quantités moindres d'inducteur (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 62).

2. Les cellules détachées peuvent ensuite être réensemencées sur microporteurs pour une subculture (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 60).

Note : Destinées à augmenter la surface de culture des cellules et permettre ainsi leur production industrielle, ces supports doivent bien entendu être totalement dépourvus de toxicité vis à vis du matériel biologique cultivé.

89. POLYMÉRISATION

voir IMMOBILISATION PAR RÉTICULATION

R T

90. RECYCLAGE DES COFACTEURS

voir RÉGÉNÉRATION DES COFACTEURS

91. RÉGÉNÉRATION DES COFACTEURS, n.f.

syn. RECYCLAGE DES COFACTEURS, n.f.

Domaine : biotechnologies/enzymologie

Définition : Phénomène obtenu en couplant une réaction mettant en jeu une enzyme à cofacteur avec une autre réaction, chimique, enzymatique ou électrochimique, rétablissant le cofacteur dans son état initial.

Contexte : 1. Régénération des cofacteurs : *[[...]]* Le cofacteur est greffé au niveau du site actif de l'enzyme et régénéré sur place (Biochimie,62 (5.6), 1980, p. 341).

2. Enfin des techniques de visualisation de l'activité des déshydrogénases sont également à l'étude dans le but de contrôler le recyclage des cofacteurs à NAD au sein de la mousse (J. N. Barbotin, Réalisation de supports artificiels porteurs d'enzymes greffées : étude morphologique et cinétique, 1979, p. 148).

Note : La régénération des cofacteurs est indispensable à la poursuite de la réaction enzymatique principale où, à chaque molécule de substrat transformée, une molécule du cofacteur est "consommée" : oxydée, réduite, etc.

92. RETENIR PAR ADSORPTION

voir IMMOBILISER PAR ADSORPTION

93. RETENIR PAR COVALENCE

voir IMMOBILISER PAR COVALENCE

94. RÉTENTION, n.f.

Domaine : biotechnologies/génie biochimique; génie enzymatique

Définition : Technique mettant en oeuvre un microorganisme, un organite cellulaire, un biocatalyseur ou une protéine et un support de nature minérale, organique ou biologique.

Contexte : Fig. 1 - Influence de l'aire spécifique et du traitement de la silice poreuse sur la rétention de S. Uvarum (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 99).

Note : Bien que souvent attesté le terme rétention est, par manque de rigueur scientifique à éviter au profit du terme immobilisation.

95. RÉTICULATION

voir IMMOBILISATION PAR RÉTICULATION

96. TAUX DE GREFFAGE, n.m.

Domaine : biotechnologies/génie biochimique; génie enzymatique

Définition : Pourcentage de matériel biologique immobilisé sur un support.

Contexte : Ces derniers montrent une affinité plus grande pour les cellules endothéliales, mais nécessitent un taux de greffage plus élevé (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 121).

97. TRYPSINATION, n.f., terme prop.

Domaine : biotechnologies/cultures de cellules

Définition : Traitement dissociatif d'un voile cellulaire par la trypsine.

Contexte : Parfois les cellules forment des aggrégats trop importants qu'il faut disperser par trypsination (S.F.M., Cellules immobilisées, 1979, p. 48).

Bibliographie

1. Corpus d'exclusion[1]

1.1. Dictionnaires généraux français

Arrêtés du gouvernement de la République française en matière de terminologie, Office de la langue française, Québec, Éditeur officiel du Québec, novembre 1978, 256 p.

Boulanger (Jean-Claude) et Legris (Nicole), Index de Néologie en marche (numéros 1 à 15), coll. "Néologie en marche", Office de la langue française, Québec, Éditeur officiel du Québec, juin 1981, 154 p.

Cellard (Jacques) et Sommant (Micheline), 500 mots nouveaux définis et expliqués, Paris/Gembloux, Éditions Duculot, 1979, 101 p.

Conseil international de la langue française, La clé des mots, Paris, CILF, cahiers nos 1 à 66, octobre 1973 à septembre 1979.

Dictionnaire Hachette de la langue française, sous la direction de Françoise Guérard, Paris, Encyclopédies Hachette, 1980, 1817 p.

Dictionnaire usuel illustré 1982, Paris, Librairies Quillet-Flammarion, 1980, 1944 p. + Atlas.

---

[1] Les modifications apportées au corpus d'exclusion n'ont pas d'effet rétroactif : tout néologisme retenu avant l'intégration de certains ouvrages ou numéros de périodiques au corpus d'exclusion, ne subit pas de nouveau filtrage.

Gilbert (Pierre), Dictionnaire des mots contemporains, coll. "Les usuels du Robert", Paris, Le Robert, 1979, XXV + 741 p.

Giraud (Jean), Pamart (Pierre) et Riverain (Jean), Les mots dans le vent, Paris, Librairie Larousse, 1971, 251 p.

Giraud (Jean), Pamart (Pierre) et Riverain (Jean), Les nouveaux mots dans le vent, Paris, Librairie Larousse, 1974, 272 p.

Girodet (Jean), Logos. Grand dictionnaire de la langue française, Paris, Bordas, 1976, 3 vol., 3113 p. + 68 annexes.

Grand Larousse de la langue française, sous la direction de L. Guilbert, R. Lagane, G. Niobey, avec le concours de H. Bonnard, L. Casati, A. Lerond, Paris, Librairie Larousse, 1971-1978, 7 vol., CXXVIII + 6730 p.

Grand Larousse encyclopédique, Paris, Librairie Larousse, 1960-1964, 10 vol.

Grand Larousse encyclopédique, Supplément 1, Paris, Librairie Larousse, 1968, 918 p.

Grand Larousse encyclopédique, Supplément 2, Paris, Librairie Larousse, 1975, s.p.

Larousse de la langue française. Lexis, sous la direction de Jean Dubois, 2e édition, illustrée, Paris, Librairie Larousse, 1979, XVI + 2111 p.

Néologie en marche, Office de la langue française, Québec, Éditeur officiel du Québec, cahier nº 16 (avril 1980) et suivants.

Petit Larousse illustré 1982, Paris, Librairie Larousse, 1981, XXX + 1800 p.

Robert (Paul), Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le Robert), Paris, Société du Nouveau Littré - Le Robert, 1958-1964, 6 vol.

Robert (Paul), Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Le Robert), Supplément, rédaction dirigée par Alain Rey et Josette Rey-Debove, Paris, Société du Nouveau Littré - Le Robert, 1970, XXI + 514 p.

Robert (Paul), Le Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, rédaction dirigée par Alain Rey et Josette Rey-Debove, Paris, Société du Nouveau Littré - Le Robert, 1977, XXXI + 2172 p.

Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIX^{e} et du XX^{e} siècle, sous la direction de P. Imbs, Centre national de la recherche scientifique, Paris, Klincksieck, 1971-1980, 8 vol. parus (a - fuyard).

I.2. Dictionnaires et ouvrages spécialisés

I.2.1. Électronique

Clason (W.E.), Elsevier's Telecommunication Dictionary - Amsterdam, Elsevier Scientific Publishing Company, 1976, 403 p.

Piraux (H.), Dictionnaire des termes relatifs à l'électronique, l'électrotechnique, l'informatique et aux applications connexes, Paris, Eyrolles, 1981, 207 p.

1.2.2. Biotechnologies

Duval (C.) et Duval (R.), Dictionnaire de la chimie et de ses applications, Paris, Technique et Documentation, 3e édition, 1978, 1 100 p.

Lender (Théodore), Delavault (Robert) et Le Moigne (Albert), Dictionnaire de biologie, Paris, Presses Universitaires de France, 1979, 437 p.

2. Corpus de dépouillement

Périodiques et autres textes

2.1. Électronique

Grove (A.S.), Physique et technologie des dispositifs à semi-conducteur, Louvain, Éditions Ceuterick, 1972, 380 p.

Mesures-Régulation-Automatisme, mensuel, C.S.U.E., 40, rue du Colisée, Paris.

2. 2. Biotechnologies

Barbotin (Jean-Noël), Réalisation de supports artificiels porteurs d'enzymes greffées : étude morphologique et cinétique. Approche d'une corrélation structure-fonction à l'aide de la technologie enzymatique, thèse de doctorat d'État en Sciences Physiques pour l'obtention du grade de Docteur es Sciences, Université de Technologie de Compiègne, 1979, 181 p.

Biochimie, bimestriel, 4, avenue de l'Observatoire, 75006 PARIS.

Société Française de Microbiologie, Cellules immobilisées, Toulouse, INSA, 1979, 227 p.

Société Française de Microbiologie, Utilisation du carbone d'origine végétale, Toulouse, INSA, 1978, 262 p.

Index

A

ACCROCHAGE, 49

ADHÉRENCE, 50

ADHÉRER, 51

ADHÉSION, 52

ADSORPTION, 53

ANCHORAGE DÉPENDANCE, 54

ANCRAGE DÉFENDANT, 55

APPROXIMATION DE DÉSERTION, 1

APPROXIMATION DE LA JONCTION LINÉAIRE GRADUELLE, 2

ASSISE CELLULAIRE, 56

ATTACHEMENT, 57

B

BIOCOMPATIBILITÉ, 58

C

CONCENTRATION EN ACCEPTEURS, 3

CONCENTRATION EN DONNEURS, 4

CONCENTRATION EN DOPEURS, 5

CONCENTRATION INTRINSÈQUE D'UN SEMICONDUCTEUR, 6

CORÉTICULATION, 59

COURANT DE DIFFUSION, 7

COURANT DE GÉNÉRATION, 8

COURANT DE RECOMBINAISON, 9

D

DÉNOMBREMENT, 60

DÉTACHEMENT, 61

DÉTACHER (SE), 62

DIODE À L'ARSÉNIURE DE GALLIUM, 10

DIODE AU GERMANIUM, 11

DIODE AU SILICIUM, 12

E

EFFET DE CONTRASTE DE POTENTIEL, 13

ÉNERGIE DE FERMI, 14

EN SUSPENSION, 63

ÉTALEMENT, 64

ÉTALER (S'), 65

F

FILM CELLULAIRE, 66

FILM DE BIOMASSE, 67

FILM DE CELLULES, 68

FILM ÉPITAXIAL, 15

FILM STAGNANT, 16

FIXATION COVALENTE, 69

G

GREFFAGE, 70

GREFFER, 71

I

IMMOBILISATION PAR ADSORPTION, 72

IMMOBILISATION PAR CORÉTICULATION, 73

IMMOBILISATION PAR FIXATION COVALENTE, 74

IMMOBILISATION PAR INCLUSION, 75

IMMOBILISATION PAR INTERACTIONS IONIQUES, 76

IMMOBILISATION PAR MICROENCAPSULATION, 77

IMMOBILISATION PAR RÉTICULATION, 78

IMMOBILISER PAR ADSORPTION, 79

IMMOBILISER PAR COVALENCE, 80

INACTIVATION, 81

INCLURE, 82

INCLUSION, 83

J

JONCTION ABRUPTE, 17

JONCTION ABRUPTE UNILATÉRALE, 18

JONCTION ALLIÉE, 19

JONCTION DIFFUSÉE, 20

JONCTION LINÉAIRE, 21

JONCTION LINÉAIRE GRADUELLE, 22

JONCTION PLANAR, 23

JONCTION PN, 24

JONCTION P-N, 25

JONCTION TIRÉE, 26

L

LIBRE, 84

M

MÉTHODE ENZYMATIQUE, 85

MÉTHODE STROBOSCOPIQUE, 27

MICROENCAPSULATION, 86

MICROPORTEUR, 87

MICROSUPPORT, 88

N

NEUTRALITÉ DE LA CHARGE D'ESPACE, 28

NIVEAU ACCEPTEUR, 29

NIVEAU DE FERMI, 30

NIVEAU DE FERMI INTRINSÈQUE, 31

NIVEAU D'ÉNERGIE DE FERMI, 32

NIVEAU D'INJECTION, 33

NIVEAU DONNEUR, 34

NIVEAU INTRINSÈQUE DE FERMI, 35

O

OXYDATION THERMIQUE, 36

P

POLARISATION DIRECTE, 37

POLYMÉRISATION, 89

PORTEUR MAJORITAIRE, 38

PORTEUR MINORITAIRE, 39

Q

QUASI-NIVEAU DE FERMI, 40

R

RECOMBINAISON PAR TRANSITION DIRECTE, 41

RECOMBINAISON THERMIQUE, 42

RECYCLAGE DES COFACTEURS, 90

RÉGÉNÉRATION DES COFACTEURS, 91

RETENIR PAR ADSORPTION, 92

RETENIR PAR COVALENCE, 93

RÉTENTION, 94

RÉTICULATION, 95

S

SEMICONDUCTEUR INTRINSÈQUE, 43

T

TAUX DE GÉNÉRATION, 44

TAUX DE GREFFAGE, 96

TAUX DE RECOMBINAISON, 45

TRYPSINATION, 97

Z

ZONE D'APPAUVRISSEMENT, 46

ZONE DE DÉPLÉTION, 47

ZONE DÉSERTÉE, 48

Table des matières

5 Avant-propos

7 Notice méthodologique

13 Abréviations

Dossiers terminologiques

15 Électronique
1 à 48
par *Myriam Urlich*

33 Biotechnologies
49 à 97
par *Hélène Rivkine*

49 Bibliographie

57 Index

Déjà parus dans la même collection

Ordre chronologique

1. **Néologie en marche**, n° 1, 1973, 52 p.
2. **Néologie en marche**, n° 2, 1974, 104 p.
3. **Néologie en marche**, n° 3, mars 1974, 72 p.
4. **Néologie en marche**, n° 4, 1974, 100 p.
5. **Néologie en marche**, n° 5, octobre 1974, 88 p.
6. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 6, novembre 1975, 84 p.
7. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 7, novembre 1975, 66 p.
8. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 1, septembre 1976, XLV + 120 p.: Sciences et techniques.
9. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 2, octobre 1976, XXI + 158 p.: Forage (pétrole); tronc commun industriel.
10. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 3, septembre 1977, XIII + 136 p.: Automatique, électronique et informatique; manutention.
11. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 5 et n° 6, avril 1978, 346 p.: Le Nord et son langage (2 fascicules), par Louis-Edmond Hamelin, Université Laval, Québec.
12. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 4, septembre 1978, 181 p.: Néologie et terminologie (étude théorique) par Jean-Claude Boulanger, Office de la langue française, Québec.
13. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 8, octobre 1978, 120 p.
14. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 7, octobre 1978, XXXIV + 64 p.: Informatique.
15. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 8, octobre 1978, XIV + 144 p.: Tronc commun industriel; automatique, électronique, informatique.

16. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 9, octobre 1978, XIII + 140 p.: Automatique, informatique; manutention; tourisme.

17. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 10, octobre 1978, XIII + 156 p.: Automatique, informatique; manutention; tourisme.

18. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 11, novembre 1978, XVII + 50 p.: Informatique.

19. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 9, janvier 1979, 78 p.

20. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 12, avril 1979, XX + 214 p.: Automatique, informatique; tourisme.

21. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 13, avril 1979, XX + 106 p.: Automatique, informatique; audio-visuel; tourisme.

22. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 10, mai 1979, 64 p.

23. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 14, juin 1979, 72 p.: Informatique.

24. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 15, août 1979, XVIII + 112 p.: Automatique, informatique, mesure; audio-visuel; planche à roulettes, par Robert Lévy, Bernard Natier et Marie-Michèle de Monléon, AFTERM, Paris.

25. **Néologie en marche**, n° 17, février 1980, XVIII + 116 p.: Automatique, informatique, mesure; audio-visuel; planche à roulettes, par Robert Lévy, Bernard Natier et Marie-Michèle de Monléon, AFTERM, Paris.

26. **Néologie en marche**, n° 18, février 1980, 153 p.: Les néologismes dans l'hebdomadaire "L'Express", par Jacques Blois, Bruxelles.

27. **Néologie en marche**, n° 16, avril 1980, 158 p.: Il y a phobie et phobie, par Gilles Leclerc, Office de la langue française, Québec.

28. **Néologie en marche**, n° 19, avril 1980, et n° 20, mai 1980, 379 p. + 8 diagrammes: Le synthétiseur, terminologie néologique (2 fascicules), par Nil Parent, Université Laval, Québec.

29. **Néologie en marche**, n° 23, juillet 1980, XVIII + 96 p.: Automatique, informatique, mesure; audio-visuel; commerce, vente, publicité, par Robert Lévy, Bernard Natier et Marie-Michèle de Monléon, AFTERM, Paris.

30. **Néologie en marche**, n° 22, août 1980, 98 p.: Équipement de protection individuelle; emballage, par Henriette Dupuis et Normand Côte, Office de la langue française, Québec.

31. **Néologie en marche**, n° 21, décembre 1980, 128 p.: Néologie et communications, par André Dorval, Université du Québec, Québec.

32. **Néologie en marche**, n° 26, mai 1981, XVI + 98 p.: Automatique, informatique et mesure; audio-visuel; économie, commerce, publicité, par Robert Lévy, Bernard Natier et Marie-Michèle de Monléon, AFTERM, Paris.

33. **Néologie en marche**, n° 24, juin 1981, 154 p.: Index de Néologie en marche (Numéros 1 à 15), par Jean-Claude Boulanger, Office de la langue française, et Nicole Legris, Québec.

34. **Néologie en marche**, n° 25, juin 1981, 112 p.: Urbanisme et environnement, par Arlette Fortin, Office de la langue française, Québec.

35. **Néologie en marche**, n° 27, février 1982, 88 p.: Épuration des eaux, lagunage; fibres optiques; route, par Dominique Gendrot, Myriam Urlich et Hélène Rivkine, FRANTERM, Paris.

36. **Néologie en marche**, n° 28, 1982, 118 p.: Index de Néologie en marche (Numéros 17 à 27), par Nicole Legris, Québec.

37. **Néologie en marche**, n° 29, 1982, 98 p.: Épuration des eaux; fibres optiques; route, par Dominique Gendrot, Myriam Urlich et Hélène Rivkine, FRANTERM, Paris.

38. **Néologie en marche**, n° 30, 1982, 142 p.: Audiovisuel: techniques et technologie de l'enseignement, par Jean-Claude Boulanger (rédacteur), Office de la langue française, Québec.

39. **Néologie en marche**, n° 31, 1982, 88 p.: Épuration des eaux; fibres optiques; énergie, par Dominique Gendrot, Myriam Urlich et Hélène Rivkine, FRANTERM, Paris.

40. **Néologie en marche**, n° 32, 1982, 196 p. et n° 33, 1982, 243 p.: Mécanisation forestière (2 fascicules), par Thérèse Sicard-Lussier, Québec.

41. **Néologie en marche,** nº 34, 1983, 92 p.: Épuration des eaux; électronique; énergies renouvelables, par Dominique Gendrot, Myriam Urlich et Hélène Rivkine, FRANTERM, Paris.

42. **Néologie en marche,** nº 35, 1983, 90 p.: Épuration des eaux; électronique; biotechnologies, par Dominique Gendrot, Myriam Urlich et Hélène Rivkine, FRANTERM, Paris.

Ordre numérique

1re série:

1. **Néologie en marche**, n° 1, 1973, 52 p.
2. **Néologie en marche**, n° 2, 1974, 104 p.
3. **Néologie en marche**, n° 3, mars 1974, 72 p.
4. **Néologie en marche**, n° 4, 1974, 100 p.
5. **Néologie en marche**, n° 5, octobre 1974, 88 p.

2e série:

1. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 6, novembre 1975, 84 p.
2. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 7, novembre 1975, 66 p.
3. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 8, octobre 1978, 120 p.
4. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 9, janvier 1979, 78 p.
5. **Néologie en marche**, série a: langue générale, n° 10, mai 1979, 64 p.

3e série:

1. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 1, septembre 1976, XLV + 120 p.
2. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 2, octobre 1976, XXI + 158 p.

3. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 3, septembre 1977, XIII + 136 p.

4. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 4, septembre 1978, 181 p.

5. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 5, avril 1978, p. 1-153.

6. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 6, avril 1978, p. 154-346.

7. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 7, octobre 1978, 120 p.

8. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 8, octobre 1978, XIV + 144 p.

9. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 9, octobre 1978, XIII + 140 p.

10. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 10, octobre 1978, XIII + 156 p.

11. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 11, novembre 1978, XVII + 50 p.

12. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 12, avril 1979, XX + 214 p.

13. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 13, avril 1979, XX + 106 p.

14. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 14, juin 1979, 72 p.

15. **Néologie en marche**, série b: langues de spécialités, n° 15, août 1979, XVIII + 112 p.

4e série:

1. **Néologie en marche**, n° 16, avril 1980, 158 p.

2. **Néologie en marche**, n° 17, février 1980, XVIII + 116 p.

3. **Néologie en marche**, n° 18, février 1980, 153 p.

4. **Néologie en marche**, n° 19, avril 1980, p. 1-192.

5. **Néologie en marche**, n° 20, mai 1980, p. 193-379 + 8 diagrammes.

6. **Néologie en marche**, n° 21, décembre 1980, 128 p.

7. **Néologie en marche**, n° 22, août 1980, 98 p.

8. **Néologie en marche**, n° 23, juillet 1980, XVIII + 96 p.

9. **Néologie en marche**, n° 24, juin 1981, 154 p.

10. **Néologie en marche**, n° 25, juin 1981, 112 p.

11. **Néologie en marche**, n° 26, mai 1981, XVI + 98 p.

12. **Néologie en marche**, n° 27, février 1982, 88 p.

13. **Néologie en marche**, n° 28, 1982, 118 p.

14. **Néologie en marche**, n° 29, 1982, 98 p.

15. **Néologie en marche**, n° 30, 1982, 142 p.

16. **Néologie en marche**, n° 31, 1982, 88 p.

17. **Néologie en marche**, n° 32, 1982, 196 p.

18. **Néologie en marche**, n° 33, 1982, 243 p.

19. **Néologie en marche**, n° 34, 1983, 92 p.

20. **Néologie en marche**, n° 35, 1983, 90 p.

Remarque

La 1re série des cahiers de **Néologie en marche** (1973-1974) recensait les néologismes de la langue générale. Les 2e et 3e séries résultaient de la création du Réseau francoquébécois de néologie scientifique et technique, divisant ainsi administrativement les travaux de néologie: une première équipe continuait les dépouillements en langue générale (1975-1979), tandis qu'une seconde équipe s'occupait des langues techniques et scientifiques (1976-1979). À l'automne 1979, le regroupement administratif de tous les travaux de néologie à l'Office de la langue française au sein d'une seule équipe de recherche a amené la fusion des deux séries de **NEM** langue générale et langues de spécialités. L'équipe qui s'occupait de la langue générale a été intégrée au Réseau de néologie. Pour cette raison, la numérotation des cahiers de la 4e série poursuit celle de la 3e série.

Gouvernement du Québec
Office de la langue française

34-5193
Imprimé au Québec, Canada